

BW769M-G 型 GaN FET 用驱动器芯片

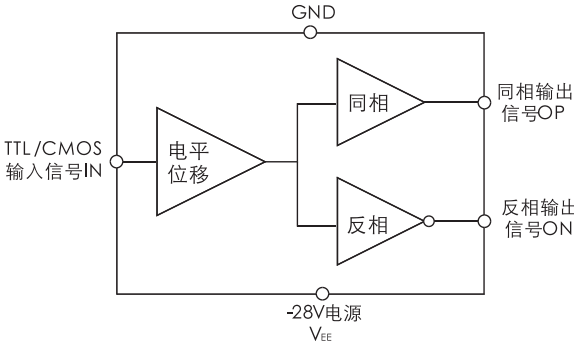
性能特点

- 输入信号：兼容 TTL/CMOS 信号
- 输出信号： V_{EE} (-48V~-10V) / 0V
- 开关延时：40ns
- 静态电流： $\leq 1.5\text{mA}$
- 芯片背面不能接地

产品概述

BW769M-G 采用 CMOS 工艺制造，由单电源 V_{EE} (-48V~-10V) 供电，可将 1 位 TTL 脉冲输入信号转换为 1 位互补输出 V_{EE} 到 0V 的脉冲信号。该产品具有功耗低、响应速度快，使用方便等特点，可应用于驱动 GaN FET 类开关器件。

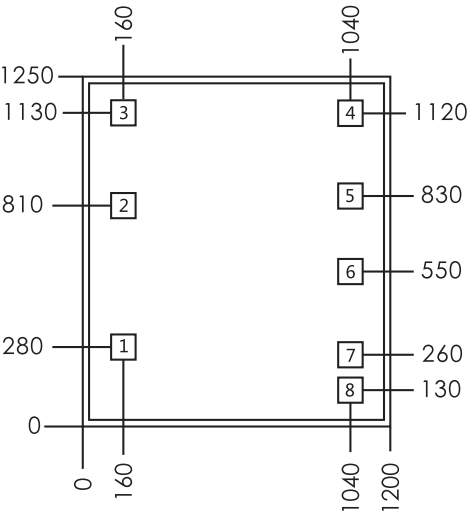
功能框图



电性能表 ($T_A=+25^\circ\text{C}$, 0/+5V 控制, 负载为 2.2pF 电容到地, $V_{EE}=-28\text{V}$)

参数名称	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{EE}	-	-48	-28	-10	V
静态电流	$ I_{OP} $	$V_{IN}=5\text{V}$	-	1.2	1.5	mA
输出高电平电压	V_{OH}	-	-0.2	0	0.2	V
输出低电平电压	V_{OL}	-	-28.2	-28	-27.8	V
开关延时 (输入 TTL 的 50% 到输出信号的 50%)	T_{ONDP}	$f=1\text{MHz}$, 同相输出开启	-	27	40	ns
	T_{OFFDP}	$f=1\text{MHz}$, 同相输出关断	-	38	45	ns
上升时间	T_{RP}	$f=1\text{MHz}$, 同相输出	-	15	25	ns
下降时间	T_{FP}	$f=1\text{MHz}$, 同相输出	-	15	25	ns

外形尺寸



键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1、3	V_{EE}	电源 (-48V~-10V)，两个引脚在芯片内部已短接
2	TTL	TTL 输入端
4、8	GND	地，两个引脚在芯片内部已短接
5、7	OP	同相输出 (输入 0V, 输出 V_{EE} ; 输入 5V, 输出 0V)
6	ON	反相输出 (输入 0V, 输出 0V; 输入 5V, 输出 V_{EE})